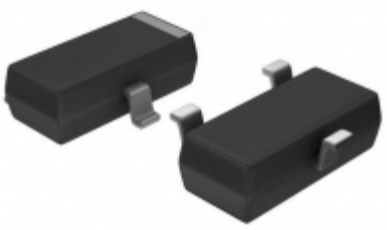




	<p>SI2335DS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2335DS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 3.2A SOT23-3</p>
	<p>Datenblätter:  SI2335DS-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
<p>Lagerzustand: New original, 33283 pcs Stock Available.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI2335DS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 3.2A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33283 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 3.2A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	51 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1225pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI2335DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2335DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2335DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2335DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2334DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A SOT-23</p>	 <p>SI2336DS VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2335DS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 3.2A SOT23</p>	 <p>SI2335DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 3.2A SOT23-3</p>
 <p>SI2334DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A SOT-23</p>	 <p>SI2336DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5.2A SOT-23</p>	 <p>SI2335DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 3.2A SOT23</p>	 <p>SI2336DS-T1-E3 VISHAY SI2336DS-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI2331DS-T1-E3 ⊕ SI2333CDS ⊕ SI2333DDS-T1-E3 D SI2333DS-T1-E3 ⇒ SI2334DS-T1-GE3 ⇒ SI2336DS-T1-E3 ⊕ SI2337DS-T1-E3 ⊕ SI2338DS-T1-GE3 ⊕ SI2341DS-T1-GE3 ⇒ SI2343CDS | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2331DS-T1-E3 ⊕ SI2333CDS-T1-E3 ⊕ SI2333DDS-T1-GE3 ⊕ SI2333DS-T1-GE3 ⇒ SI2335DS-T1 ⇒ SI2336DS-T1-GE3 D SI2337DS-T1-GE3 ⊕ SI2341DS ⊕ SI2342DS-T1-E3 ⊕ SI2343CDS-T1-E3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2331DS-T1-GE3 D SI2333CDS-T1-E3 ⊕ SI2333DDS-T1-GE3 ⊕ SI2333DS-T1-GE3 ⊕ SI2335DS-T1-E3 D SI2336DS-T1-GE3 ⇒ SI2337DS-T1-GE3 ⇒ SI2341DS-T1-E3 ⊕ SI2342DS-T1-GE3 ⊕ SI2343CDS-T1-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> D SI2331DS-T1-GE3 ⇒ SI2333CDS-T1-GE3 ⇒ SI2333DS ⊕ SI2334DS-T1-E3 ⊕ SI2335DS-T1-E3 ⊕ SI2337DS ⇒ SI2338DS-T1-E3 ⇒ SI2341DS-T1-E3 D SI2342DS-T1-GE3 ⊕ SI2343CDS-T1-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2333ADS-T1-GE3 ⇒ SI2333CDS-T1-GE3 ⇒ SI2333DS-T1-E3 ⇒ SI2334DS-T1-GE3 ⇒ SI2335DS-T1-GE3 ⊕ SI2337DS-T1-E3 ⇒ SI2338DS-T1-GE3 ⇒ SI2341DS-T1-GE3 ⇒ SI2343ADS-T1-GE3 ⇒ SI2343DS-T1-E3 |
|--|--|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited